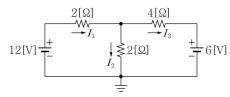


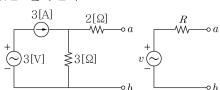
(1번~20번)

(9급)

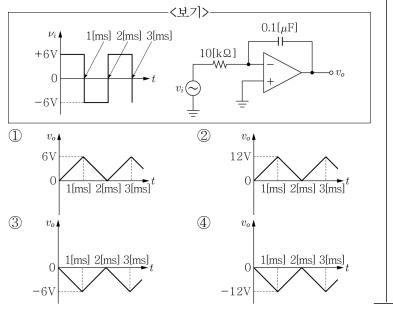
- 1. 두 평행판 사이에 공기가 채워져 있는 정전용량(Capacitance) 이 $1[\mu F]$ 인 커패시터에 전극 간격의 1/3 두께를 가지는 유리판을 전극에 평행하게 넣는 경우 그 결과 얻어지는 정전 용량은 얼마인가? (단, 유리의 비유전율은 2라고 가정한다.) ① $1[\mu F]$ ② $1.2[\mu F]$ ③ $1.5[\mu F]$ ④ $6[\mu F]$
- 2. 다음에 주어진 회로의 부하에서 소비되는 전력이 최대가 되는 부하저항 $R_L[\Omega]$ 의 값으로 옳은 것은?
 - 1 3[Ω] $26[\Omega]$ 6[Ω]≶ $R_L[\Omega]$ $39[\Omega]$ $4 12[\Omega]$
- 3. 다음 주어진 회로에서 각 저항에 흐르는 전류 $I_1[A]$, $I_2[A]$, $I_3[A]$ 값으로 옳은 것은?



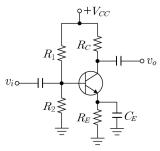
- ① $I_1=3[A], I_2=3[A], I_3=0[A]$
- ② $I_1 = 3[A], I_2 = 2[A], I_3 = 1[A]$
- $3I_1=3[A], I_2=1[A], I_3=2[A]$
- (4) $I_1=3[A]$, $I_2=0[A]$, $I_3=3[A]$
- 4. 아래 왼쪽 그림의 회로에 대하여 테브난(Thevenin)정리, 노턴(Norton)의 정리, 중첩의 원리를 이용하여 오른쪽 그림과 같은 테브난 등가회로를 구하고자 한다. v[V]와 $R[\Omega]$ 의 값은 얼마인가?



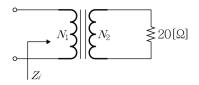
- ① $v = 6[V], R = 3[\Omega]$
- ② $v = 9[V], R = 3[\Omega]$
- ③ $v = 6[V], R = 5[\Omega]$
- (4) $v = 9[V], R = 5[\Omega]$
- 5. 〈보기〉의 연산 증폭기 회로에서 구형파 전압 (v_i) 이 인가될 때, 출력 전압 (v_o) 의 파형을 옳게 그림으로 나타낸 것은? (단, 콘덴서의 초기전압은 0이며, 연산 증폭기는 이상적이고 입력신호의 동작주파수 범위에서 선형 동작을 한다고 가정 한다.)



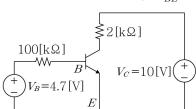
6. 다음의 BJT 증폭기 회로에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?



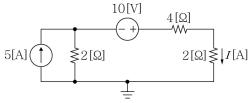
- ① 에미터 저항 R_E 는 증폭기의 동작점을 안정화 한다.
- ② 바이패스 콘덴서 $C_{\!\scriptscriptstyle E}$ 를 제거하면 증폭기의 전압이득이 증가
- ③ 바이패스 콘덴서 C_E 를 제거하면 증폭기의 입력 임피던스가 증가한다.
- ④ 증폭기의 입력 (v_i) 과 출력 (v_o) 은 서로 역위상이다.
- 7. 다음 그림은 권선 수 비가 10:1(N₁:N₂)인 변압기 2차 측에 20[Ω]의 부하를 연결한 모습을 나타낸 것이다. 변압기 1차 측에서 바라본 임피던스 (Z_i) 로 옳은 것은? (단, 변압기는 이 상적 변압기로 가정한다.)



- ① $2[\Omega]$
- ② $20[\Omega]$
- (3) $200[\Omega]$
- (4) $2.000[\Omega]$
- 8. 다음과 같은 회로에서 에미터 전류 I_{E} 는? (단, 전류이득 β =100이고 실리콘 트랜지스터이며, V_{BE} =0.7[V]이다.)



- ① 0.04 [mA] ② 4.0 [mA] ③ 4.04 [mA] ④ 4.4 [mA]
- 9. 다음의 독립 전압원과 독립 전류원으로 주어진 회로에서 $2[\Omega]$ 의 저항에 흐르는 전류(I)는?



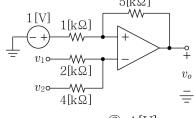
- ① 1.67[A]
- ② 2.50[A] ③ 3.33[A]

- 10. 접합 트랜지스터에서 α 와 β 의 관계는?

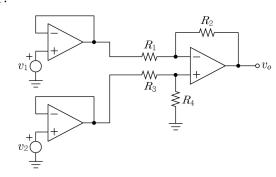
(단,
$$\alpha = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_E}$$
, $\beta = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_B}$)



- 11. PN접합에서 순방향으로 전압을 걸어줄 때 나타나는 현상 으로 옳은 것은?
 - ① 다수의 캐리어가 서로 다른 쪽에 주입된다.
 - ② P형 쪽의 전자만이 N형 쪽으로 주입된다.
 - ③ P형 쪽의 정공만이 N형 쪽으로 주입된다.
 - ④ 전류가 거의 흐르지 않는다.
- 12. 다음 회로에서 v_1 =2[V], v_2 =1[V]일 때, 출력단의 전압 v_a [V]는?



- ① 3[V]
- ② 4[V]
- 3 5[V]
- 4 6 [V]
- 13. $R_1 = R_2 = 1$ [kΩ], $R_3 = R_4 = 2$ [kΩ]일 때, 아래 회로의 관계 식은?

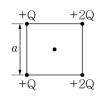


- ① $V_0 = V_1 2V_2$
- ② $V_o = V_2 V_1$
- $(3) V_o = 2V_2 V_1$
- $(4) V_0 = 2(V_2 V_1)$
- 14. 이상적인 연산증폭기의 특성이 아닌 것은?
 - ① 전압 이득이 무한대
 - ② 대역폭이 무한대
 - ③ 출력저항이 무한대
 - ④ 오프셋이 0
- 15. <보기>의 부울 함수를 간소화한 결과로 옳은 것은?

(보기)>
$$F = \overline{A} C + \overline{A} B + A \overline{B} C + B C$$

- ① $F = C + \overline{A}BC$
- \bigcirc $F = C + \overline{A}B$
- $\bigcirc 3 F = C + B$

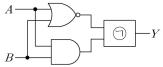
16. 한 변의 길이가 a[m]인 정사각형의 꼭짓 점에 다음과 같이 +Q[C] 또는 +2Q[C] 의 전하량을 가지는 전하를 놓을 때 정사 각형의 중심에서의 전계[V/m]의 세기는? +Q



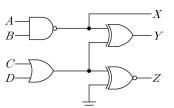
 $\bigcirc 0$

 $\Im \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 a^2}$

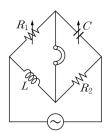
- $\frac{Q}{\sqrt{2}\pi\epsilon_0 a^2}$
- 17. 다음의 회로가 XNOR(exclusive NOR)로 동작하기 위해 ① 안에 하나의 논리 게이트(logic gate)소자만 들어갈 경우, 해당 논리 게이트 소자로 옳은 것은?



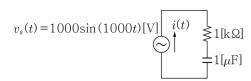
- ① AND
- ② NAND
- ③ OR
- 4 NOR
- 18. 다음 논리회로에서 A=0, B=1, C=1, D=0일 때, 출력 X, Y의 논리 상태로 옳은 것은?



- ① X=1, Y=0, Z=0
- ② X=0, Y=1, Z=0
- ③ X=0, Y=0, Z=1
- 4 X=1, Y=1, Z=0
- 19. 그림과 같은 교류 브리지(bridge)의 평형조건은?



- 20. 다음 회로에서 교류 전압원 $v_s(t)=1000\sin(1000t)$ [V] 가 인가될 때 흐르는 전류 i(t)를 구한 것으로 옳은 것은?



- ① $\sqrt{2} \sin(1000t 45^{\circ})$ [A]
- ② $\frac{1000}{\sqrt{2}}\sin(1000t+45^\circ)$ [A]
- $3 \frac{1000}{\sqrt{2}} \sin(1000t 45^{\circ}) [A]$
- $4 \frac{1}{\sqrt{2}}\sin(1000t + 45^{\circ})$ [A]